

杰理方案咨询(QQ号:1418295957, 邮箱:fae@zh-jieli.com)

- 線磁理 住意供电电压,严格控制使用场景 (电主407年,只能使用VPW接近点电,且IOVDD接进槽电容。 电主407号,使用VDD接近向性(VPWR基学),可支持最低功能。 注意调度使护,的设压过地反接的通管。但如如电池原用,必须考虑的反接电路保护)。 电热电力系像等的发光功能(GPM发展解集级功能)。

- 原确选型。 。抗损治值一般要求≥±48V(根据实际应用场景调整),建议留有余量设计。 5、DCSV还配器或USBSV供电,VPWR输入端必须加TVS管,请使用排养型号。

设计注意事项

- 1. (1970年) (

IO名词解析

VPMX、方片供电池、信仰电温WF,从他把IVPMR报之界电)。 EVDD. LDGE指摘形。或方式传播外观(信仰电温WF,使用EVVDDD报之界电,可支持器结构形 ADCs. ADCE用的之間(对话题)。 Update、中心支部的下 SSS、黄宁海及上系统地。

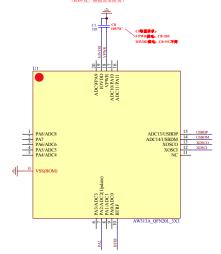
BT ANT

XTAL

n-医型块物: 负载电容: ≤10pF(32.25封装),≤8pF(2016封装) 典型推荐: 9pF(Typ)。

注意: VPWR耐压<=5.5V, IOVDD耐压<=3.6V

最小系统参考



注意: AW313A为QFN20L封装,芯片衬底地比以往QFN20封装大,设计注意规避(详见芯片规格书)

烧写场景说明

1	挽写场景	VP WR 供电	IOVDD 供电
ı	USB更新程序	VPWR、USBDM、USBDP、GND	IOVDD, USBDM, USBDP, GND
1	串口更新程序	VPWR、PA2、GND	IOVDD, PA2, GND

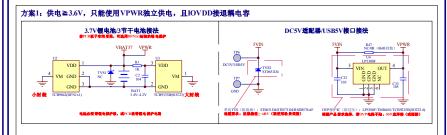
预留测试点,方便烧写、升级、测试



TEST POINT

供电场景说明

供电压	供电接法	适用场景
≥ 3.6V	供电至VPWR (IOVDD接退耦电容)	如3.7V锂电池/3节干电池、DC5V适配器/USB5V接口等
<3.6V	供电至IOVDD (VPWR悬空)	如3.0V纽扣电池/2节干电池应用
注:电源输入需做好保护,	防过压/过流/反接/狼涌/静电等。连接外证	设时,应避免过载输出。





以上方案二选一

POWER

MCU